

Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Fen ve Mühendislik Dergisi Dokuz Eylul University Faculty of Engineering Journal of Science and Engineering

Basılı/Printed ISSN: 1302-9304. Elektronik/Online ISSN: 2547-958X

# Negatif elektrik yükü taşıyan *E. faecalis* bakterilerinin elektrik alan etkisi ile farklı gözenekli boyutlarda üretilen GS/Si yapılara yaklaştırılması sonucu iletkenlik ve kapasitans değişimleri

Changes in conductivity and capacitance as a result of the approach of *E. faecalis* bacteria carrying negative electrical charge to PS/Si structures produced in different porous sizes with the effect of electric field

## Sevinç Güler <sup>1\*</sup><sup>(1)</sup>, Çiğdem Oruç <sup>2</sup><sup>(1)</sup>

 <sup>1</sup> İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İzmir, TÜRKİYE
 <sup>2</sup> Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü, İstanbul, TÜRKİYE Sorumlu Yazar / Corresponding Author\*: <u>sevinc7guler@gmail.com</u>

 Geliş Tarihi / Received: 27.02.2021
 Araştırma Makalesi/Research Article

 Kabul Tarihi / Accepted: 20.06.2021
 DOI:10.21205/deufmd.2022247024

 <u>Attş şekli/ How to cite: GÜLER,S,ORUÇ,C</u> (2022). Negatif elektrik yükü taşıyan E. faecalis bakterilerinin elektrik alan etkisi ile farklı gözenekli

 boyutlarda üretilen GS/Si yapılara yaklaştırılması sonucu iletkenlik ve kapasitans değişimleri.DEUFMD, 24(70), 263-275.

#### Öz

Bakterilerin elektrik yükü taşıması, elektrik alanından etkilenebileceklerinin bir göstergesidir. Buna örnek olarak, negatif elektrik yükü taşıyan *Enterococcus faecalis* (*E. faecalis*) bakterilerinin elektrik alan etkisi ile istenilen bir yöne doğru hareket ettirilebildiği tespit edildi. Çalışmada, gözenekli silisyum (GS) tabanlı sensör platformlarını elde etmek için n tipi tek kristal silisyum kullanılarak farklı parametrelerde uygulanan elektrokimyasal anodizasyon işlemi sonucu %60 gözeneklilik (7-15 µm gözenek boyutlarında) ve % 50 gözeneklilik (1-5 µm gözenek boyutlarında) olmak üzere iki farklı özellikte In/Si/GS/Ag yapılar elde edildi. Elde edilen bu GS tabanlı yapılar, negatif elektrik yükü bulunan *E. faecalis* bakterisi içeren sıvılara daldırılarak 0-5 kV/cm elektrik alan değerlerinin ileri yönde ve ters yönde uygulanması sonucu gözeneklere bakteri yaklaştırılması ve uzaklaştırılmasına farklı boyutlarda üretilmiş gözeneklerin etkisinin gösterilmesi amaçlandı. Gözenek boyutlarının ayarlanabilir olması nedeniyle bakterilerin farklı gözenek boyutlarına sahip yapılardaki elektriksel ölçümleri incelenerek, frekansa bağlı iletkenlik-frekans ve kapasitansfrekans değerleri tartışıldı.

Anahtar Kelimeler: Gözenekli silisyum, E. faecalis, Empedans spektroskopisi, Elektrik alan.

#### Abstract

The fact that bacteria carry an electric charge is an indication that they can be affected by the electric field.As an example, it has been determined that *Enterococcus faecalis (E. faecalis)* bacteria carrying negative electrical charge can be moved in a desired direction by the effect of electric field.In this study, the porous silicon (PS) based sensor platform for obtaining the n-type single crystal electrochemical anodization process results apply to different parameters using silicon 60%

porosity (7-15µmin pore size) and 50% porosity (the 1-5 µmpore size) to In / Si / PS / Ag structures with two different properties were obtained. These PS-based structures obtained were immersed in fluids containing negative electric charge *E. faecalis* bacteria and 0-5 kV / cm electric field values were applied in forward and reverse direction to show the effect of pores produced in different sizes on the approach and removal of bacteria to the pores. Since the pore sizes are adjustable, the electrical measurements of bacteria in structures with different pore sizes were examined, and the frequency-dependent conductivity-frequency and capacitance-frequency values were discussed. *Keywords: Porous silicon, E. faecalis, Impedance spectroscopy, Electric field* 

## 1. Giriş

Gözenekli Silisyum (GS), geniş iç yüzey alanı, ayarlanabilir gözenek boyutu, gözenekliliği ve üretim kolaylığı nedeniyle biyosensör uvgulamaları icin umut verici bir materval olarak kullanılmaktadır [1]. Hidroflorik asit (HF) içinde elektrokimyasal aşındırma yöntemi ile (anodizasyon) elde edilen gözenekli silisyum, HF konsantrasyonu, sıcaklık, iletkenlik tipi, ışınlama ve anodizasyon zamanı, akım yoğunluğu gibi etkenleri değiştirilerek incelendi [2]. Elektrolitte HF konsantrasyonu, akım yoğunluğu, silisyum katkı maddelerinin yoğunluğu, aydınlatma işlemi ve aşındırma süresi gibi parametrelere bağlı olarak birkaç nanometreden birkaç mikrometreye kadar değişen çeşitli gözenek boyutları elde edilebilir olduğu ve gözenek boyutuna bağlı olarak, GS ' nin, mikro gözenekli (≤ 2 nm), mezo gözenekli (2-50 nm) ve makro gözenekli (>50 nm) olmak üzere üç gruba ayrılabilir olduğu bildirildi [3]-[5]. HF oranı ve akım yoğunluğunun mezo gözenekli silisyumun gözenekliliğine ve yüzey alanına etkileri incelendi [6].

Gözenekli silisyum son zamanlarda biyosensör uygulamaları için potansiyel bir platform olarak araştırılmaktadır. GS, optik özellikleri sayesinde çok çeşitli biyosensörlerin geliştirilmesinde başarıyla kullanılmaktadır [7]. Gözenekli silisyum (GS), sensörler, biyosensörler ve özel tıbbi amaçlar için umut verici bir malzemedir [8]-[10]. Gözenekli silisyum, bakterilerin biriktirilebileceği büyük yüzey alanı avantajına nedenivle kullanılan sahip olması hir malzemedir [11]. Gözenekli yapı içine bakteri depolanmasında bakterilerin özelliklerinin Klebsiellaoxvtoca (Ecoli ve Rhodococcusrhodochrous) ve gözenek boyutlarının etkili olduğu [12] bildirildi. Gözenekli silisyumun biyosensör uygulaması, biyolojik kültürlerin biriktirilmesi için pasif platformlarda kullanımı da içerir [13], [14]. Uygulanan elektrik alanının cam substrat üzerine bakteri birikiminin etkisinin varlığı [15] belirlendi. Gıda endüstrisinde *E. coli*' nin optik tespiti için spesifik antikor fonksiyonelleştirilmiş GS' ye davalı bir biyosensör geliştirildi [16]. Algılama için empedans tabanlı bir sensör antikor konjuge kullanılarak küçük hacimlerde patojenik bakteriler bir algılama birimi olarak altın nanopartiküllerin varlığı [17] tespit edildi. Empedans spektroskopi, yüksek hassasiyet ve vüzev bağlama olaylarını cözelti empedansından ayırma yeteneği gibi avantajlar sağlamaktadır [18], [19]. Aynı parametrelerde üretilen üc sensörü farklı Salmonella *typhimurium* konsantrasyonlarında 100 Hz ve 1 MHz frekans aralığında empedans spektroskopi ölçümleri ile elektriksel olarak incelediler. Grafik sonuçlarından, 500 Hz'lik bir frekansta 150 kΩ ile 45 kΩ arasında değiştiği ve empedansta %75' lik bir azalma meydana geldiği görülmektedir. Bu nedenle, S. *typhimurium*' un neden olduğu empedanstaki değişime çift katmanlı kapasitans hakim olduğu yazarlar tarafından bildirildi [20]. Farklı kalınlıklarda gözenek boyutlarına sahip (3, 8 ve 12 µm) ve % 55 gözenekliliği olan üç farklı makro gözenekli silisyum elde edilerek silisyum tabanlı yapıların farklı E. coli konsantrasyonlarında 100 Hz ile 1 MHz frekans aralığında empedans spektroskopisi ile elektriksel ölcümleri alındı. Sabit bakteri konsantrasyonunda bakteri yerleşmeden önce gözenekli silisyum tabaka kalınlıklarının değerlerinin artmasıyla empedans değerlerinde bir artış gözlenirken, bakterilerin gözeneklere yerleşmesinden sonra üç farklı kalınlıktaki yapılar için empedans değerlerinde bir azalma meydana geldiği gösterildi [21]. Buna ek olarak, çalışmava yılında yapılan 2012 göre. empedanstaki düşüş yüzdesinin daha düşük frekans aralığında daha fazla olduğu ve 1kHz'den sonra azaldığı gözlemlediler [22]. Mikrosensör platformu kullanarak 100 Hz ile 100 MHz frekans aralığında S. mutans ve P.

aeruginosa konsantrasyonlarını tespit etmek icin empedans ölcümleri incelendi [23]. Bakterilerin, kontrollü büyüme koşulları altında tek tip boyutlu çiftler ve tetrad kümeleri halinde birleştiğini gösterildi ve bu tetrad kümelerinin harici bir AC elektrik alanı varlığında kendi kendine birleşmesi incelendi. Buna dayanarak yazarlar bir dış uyaranla (AC alanı) harekete geçirilen bakteriyel tetradlardan elde edilen bu kendiliğinden birlestirilmis vapıların. değiştirilebilir işlevlere sahip biyomateryallerin imalatında kullanım bulabileceğine gösterdi [24]. Yüksek yerel elektrik alan kuvveti olusturabilen paketlenmis silisyum boncuklar kullanan yeni bir bakteriyel inaktivasyon cihazı geliştirildi. Bu cihazın, mikroorganizmaları geleneksel elektroporasyon sistemlerine kıyasla çok daha düşük voltajda sürekli olarak etkisiz hale getirebildiği gözlendi [25]. Fenol atık suyunun arıtılması için MBR'de (EMBR) uygulanan uzun vadeli elektrik alanındaki toplulukların mikrobival membran zehirlenmesi ve kaymaları sistematik olarak araştırıldı [26]. Dielektroforez (DEP) altında Bacillus subtilis bakteri inci zinciri sırasıyla pozitif ve negatif dielektroforetik kuvvet altında olusumunu inceleverek AC / DC elektrik alanları ve parçacık izleme modülleri ile basit bir simülasyon aracılığıyla, bakterilerin DEP aracılığıyla iki elektrot arasındaki boşlukta inci zincir halinde kendi kendine organize olma mekanizmasının varlığı gözlemlendi [27].

Tarafımızdan, daha önce elektrik alan etkisi ile negatif elektrik yükü taşıyan E. coli bakterisi % 60 gözenekliliğe sahip GS esaslı platforma yönlendirilerek empedans spektroskopisi yöntemi ile incelemeler yapıldı. Uygulanan elektrik alan 0-10 kV/cm aralığında incelenerek frekansa bağlı empedans değerleri tartışıldı [28]. Bu çalışmamızdaki amacımız, dışarıdan uygulanan elektrik alan yardımı ile negatif elektrik yükü taşıyan E. faecalis bakterisini hareket istenen yöne ettirilebildiğini göstermektir. Bu amaç için GS tabanlı sensör platformları kullanıldı. Farklı gözenek özelliklerinde hazırlanan GS platformları, E. faecalis bakterisini iceren sıvılar icerisine yerleştirilmiş, önce elektrik alan yokken sensörün elektronik tepkisi, iletkenlik ve kapasitansın frekansa bağlılığı şeklinde ölçüldü. Sonra avnı sisteme dısarıdan elektrik alan uygulanarak elektronik tepki olarak iletkenlik ve kapasitansın frekansa bağlılığı tespit edilip, karşılaştırmalar yapıldı. Ayrıca, deneyler

dışarıdan uygulanan elektrik alanın yönü tersine çevrilerek tekrarlanarak sonuçlar karşılaştırıldı. Tüm bu etkiler iki ayrı gözenek karakterine sahip platformlar için tekrarlandı ve incelendi.

## 2. Materyal ve Metot

## 2.1. Elektrokimyasal anodizasyon yöntemi ile farklı gözenek boyutlarında GS/Si yapıların üretimi

Farklı boyutlardaki gözenekli silisyum yapıları elde etmek için (111) yönelimli ve 1.25 × 10<sup>-2</sup>  $\Omega$ .cm özdirencli Antimon (Sb) katkılı n tipi tek kristal silisyum malzemeler elektrokimyasal anodizasyon işlemine tabii tutuldular. İstenilen kalitede bir GS/Si yapı oluşturabilmek için yarıiletkenin yüzeyini çok iyi temizlenerek yarıiletkenin birçok yüzey kusurunun ortadan kaldırılması hedeflendi.Bu ilk aşama GS/Si yapıların performansı da önemli ölçüde etkilenmiş olacaktır. Temizleme aşamasından sonra silisyum variiletkeni arka yüzeyi Indiyum (In) metali ile lehimlenmiş ve malzemeyi korumak için de aside dayanıklı balmumu ile kaplandı. Anodizasyon kosullarındaki parametrelerin değisimi ile gözenek boyutlarında değişiklik yapılabilinmektedir. Bu çalışmada iki farklı gözenek tipine ait yapılar kullanıldı. Gözenekli silisyumun elde edilmesi icin vapılan elektrokimvasal anodizasvon işlemindeki numunelerin bir kısmı 15 mA/cm<sup>2</sup> sabit akım yoğunluğunda, HF:dH<sub>2</sub>0 oranı 1:3 olacak şekilde 40 dakika boyunca 50 W 12 V halojen lamba islemine tabi tutulmustur. Bu elektrokimyasal islem sonucu elde edilen GS/Si vapılar, Örnek-1 olarak adlandırıldı. Numunelerin diğer kısmı ise 15 mA/cm<sup>2</sup> sabit akım yoğunluğunda, HF:dH<sub>2</sub>0 oranı 1:7 olacak sekilde 40 dakika boyunca 50 W 12 V halojen lamba işlemine tabi tutuldu. Bu parametrelerle elde edilen GS/Si yapılar ise Örnek-2 olarak adlandırıldı. Düzenekte kullanılacak olan malzemelerin HF asidi ile bir reaksiyon göstermemesi için elektrot olarak platin (Pt) tel kullanıldı. Elde edilen In/Si/GS yapılar sıvı gümüş boya ile In/Si/GS/Ag yapı haline getirildi [29]. GS örneklerini yüzey morfolojisini araştırmak için (JEOL 6510-LV JSM ) taramalı elektron mikroskopisi (SEM) tekniği kullanıldı.

#### 2.2. Biyolojik ve fiziksel deneyler

Bu çalışmada kullanılan bakteri suşu *E. faecalis*, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi,

## DEÜ FMD 24(70), 263-275, 2022

Mikrobiyoloji Laboratuvarı tarafından temin edildi. Bakteriler 37 ºC de Mueller-Hinton Agar' da (MHA) yetiştirildi. Biriktirme deneyi sırasında, sıvı ortam olarak 30 mM NaCl çözeltisi (serum fizyolojik % 9) kullanıldı. Denevde kullanılan bakteriler Agar ile temas etmeden üst kısımdan alındı. 22-24 saat inkübasyon süresinden sonra test edilecek E. faecalis konsantrasyonları Shimadzu UV-1280 Multipurpose cihazı kullanılarak UV-VIS 600 nm dalga boyu spektrofotometresinde McFarland standartları haz alınarak hazırlanmıştır. Test edilecek örnekler için 2x107 cfu bakteri konsantrasyonu hazırlandı. GS numunelerinin bir petri kabındaki bakteri solüsyonuna daldırılmasından sonra, iki alüminyum (Al) metal paralel plaka kapasitör konfigürasyonuna yerleştirildi. İletkenlik ve kapasitans spektrumları, 5 Hz ila 100 kHz frekans aralığı için bir HP 4192A empedans analizörü kullanılarak gerçekleştirildi. İletkenlik ve kapasitans ölçümleri sırasında Al plakalarına 0-5 kV/cm arasında bir elektrik alanı uygulandı. Deney düzeneğinin şematik bir diyagramı (daha önce E. coli elektrik alan etkileşimini incelediğimiz sistem ile aynıdır) Şekil 1'de gösterilmektedir [28].



Şekil 1.Deney düzeneği şematik gösterimi[28].

## 3. Bulgular

aşındırma yönteminde Elektrokimvasal kullanılan parametrelerin değiştirilmesi ile farklı boyutlarda gözenek elde edilebileceği bilinmektedir [30]. Elektrokimyasal aşındırma işlemi sonrası gravimetrik yöntem uygulayarak, Örnek-1 için; gözeneklilik % 60, Örnek-2 için ise; gözeneklilik % 50 olarak belirlendi. Ayrıca, yüzey morfolojisi için örnekler bir tarama elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak incelendi. Sekil 2.a ve 2.b' de, tipik bir GS görünüşü örneğinin üstten olan SEM görüntüleri gösterilmektedir. Örnek-1' in gözeneklerinin (çukurların) ortalama çapı 7-15 μm, ve Örnek-2' nin gözeneklerinin (çukurların)

ortalama çapı 1-5 µm olarak belirlendi. HF:dH2O 1:7 oranının kullanılmasıyla çözelti derişik bir halden daha seyreltik bir hale getirildi. Çözeltide HF oranının artmasıyla dağlamalar azalmakta ve gözenek oluşumunda bir azalma meydana gelmektedir. Bu nedenle gözenek boyutlarında da bir küçülme meydana gelmektedir.





#### b.

#### Şekil 2. (a) Örnek-1 ve (b) Örnek-2 GS tabanlı yapıların SEM görüntüleri

Bu çalışmanın temel amaçlarından biri, uygulanan elektrik alanın bakteriyel hücrelerin farklı boyutlara sahip makro gözenekli yapılar birikimi üzerindeki üzerine etkisini arastırmaktır. GS tabanlı cihazlar, sabit *E. faecalis* konsantrasvonu ile biriken bakteri miktarını tahmin etmek için elektriksel olarak edildi. Cihazların karakterize empedans spektroskopi tekniği ile karakterizasyonu sırasında, elektrod-elektrolit arayüzünde

iletkenlik ve kapasitansın herhangi bir rastgele dalgalanmasını önlemek için In ohmik temas ve Ag üst temas arasına 250 mV genlik bir sinüs dalgası uygulandı.

Çalışmada kullanılan GS tabanlı In/GS/Si/Ag sensör platformları deney ortamı icin hazırlanan serum fizyolojik ve bakteri içeren sıvı içerisine sırasıyla daldırılarak ölçümler alındı. Besi verinin kalabalık ve stresli olması nedeniyle bakteriler serum ile seyreltildi. Agarda üstten bakteriye temas edilmeden deneye hiçbir besi yeri eklenmediği için elektriksel değerlerde mevdana gelen değişimlere bakteriler neden oldu.

Bu çalışmanın diğer amacı ise, günümüzde kullanılan bakteri sensörlerinin etkinliğini ve ölçüm hassasiyetini artırmak için bir yöntem sağlamaktır. Bu sensörlerde bakterilerin, sensör yüzeyi ile temas etmeleri yüzeyde bulunan antibadi veya aptemer ile bağlanabilmeleri çok önemlidir. Sensörlerin bakteri tespiti bu temasa bağlıdır. Dışarıdan uygulanan elektrik alan etkisi ile söz konusu bakteriler, sensör yüzeyine doğru hareket ettirilebilirler ve sensör yüzeyi ile etkileşimleri artar. Bu artış sensörlerin ölçüm aralığını ve hassasiyetini artırır.Bu çalışmada bakteri birikiminin farklı makro boyutlara sahip gözeneklerde birikmesi fikrini genisletmevi amacladık. Elektrik alanın cihazın iletkenlik ve kapasitans spektrumları üzerindeki etkisini görmek için elektrokimyasal işlem yoluyla farklı makro boyutlarda üretilen Örnek-1 ve Örnek-2 isimli GS tabanlı vapılar önce sadece serum fizvolojik iceren bir kabın içine yerleştirildi. Bu durumda GS ve alt kontak arasındaki iletkenlik-frekans değişimi ölçüldü. Ardından, 2x107 cfu' luk bir bakteri cözeltisine daldırıldı ve iletkenlik spektrumları 0-5 kV/cm arasında çeşitli elektrik alan değerleri altında alındı (Şekil 3.a, 3.b). E.faecalis bakterileri negatif yüklü oldukları icin GS yüzeyi ile etkileştiklerinde iletkenlik değerlerinin artmasına neden oldu. Elektrik alan arttıkça daha fazla bakteri GS yüzeyi ile etkileşerek iletkenliği arttırdı. Bu sonuçlar, GS tabanlı sensör platformlarının serum ortamı ile bakteri ortamını ayırt edebildiğini ve buna ek olarak elektrik alan değerlerinin artmasıyla cihazın elektriksel parametrelerinde değişimlerin olduğunu belirtmektedir. Negatif vüklü E. faecalis bakterilerini GS yüzeyine doğru itmek için alt elektroda pozitif voltaj uygulandı. Bakteri konsantrasyonu sabit olmasına rağmen,

gözlemlenen iletkenlik spektrumlarındaki artma, uvgulanan elektrik alanın etkisini acıkca gösterir ve araştırılan tüm frekans değerleri için uygulanan elektrik alanı ile GS platformun iletkenliği artar. Elektrik alanın varlığı iletkenlik değerlerinin artmasında daha etkindir. Sekil 3.a ve 3.b incelendiğinde her iki örnek içinde elektrik alanın artmasıyla iletkenlik değerlerinde bir artışa neden olduğu görüldü. Düsük frekans bölgesindeki iletkenlik değerlerinde yüksek frekans bölgesine göre daha az bir değişim görülmektedir. Örnek-1 ve Örnek-2 cihazları için benzer durum olan bu iletkenlik değerlerindeki artısın nedeninin, cift tabaka kapasitansının düsük frekans bölgesine hakim olması sonucu empedans (direnç) değerlerinde hızlı bir azalma meydana getirdiği ve buna bağlı olarak iletkenliği arttırdığı düşünülmektedir. Yüksek frekans bölgesinde ise alternatif akım (a.c.) sinyalinin değişimini takip edebilmek için yeterli zamanı bulunmadığından empedans değerlerinde çok az bir değişim olduğu görülmektedir. GS platformunun empedansının düşük frekans bölgesinde önemli ölçüde azalmasından, alternatif akım (a.c.) iletkenliğinin frekans ve tek gevşeme süreci ile arttığı sonucuna varılabilir [31]. Buna ek olarak, gözenek büyüklüğünün, gözeneklere yakalanabilecek türleri sınırlayan çökelme uygulamaları için önemli bir faktör olduğu iyi bilinmektedir [32]. Bu gözlem, uygun şekilde yönlendirilmiş bir elektrik alanının, 15 mA.cm-2' lik sabit akım koşulları altında hazırlanan farklı makro gözenek boyutlarındaki GS tabanlı yapıların yüzeyinde bulunan gözeneklerine faecalis bakterilerinin birikmesini Е. kolaylaştırabileceğini bir kez daha ortaya koymaktadır. [33] ve [34] artan elektrik alanı ile depolanan fai ve virvonların savısının arttığını gözlemlediler.

Sonuçların daha net anlaşılabilmesi için, Örnek-1 ve Örnek-2 cihazları icin 5x10<sup>3</sup> Hz sabit frekansında 0 ila 5 kV/cm ileri yönde uygulanan elektrik alan değerlerindeki iletkenlik değişimleri incelendi (Şekil 3 (c,d)). Bu sonuca göre elektrik alan etkisi ile bakteriler farklı makro gözenekliliğe sahip yapılardaki GS yüzeyine daha çok yaklaşırlar ve negatif elektrik yükü taşıdıkları içiniletkenlik değerlerinde birartısa sebep olurlar. Örnek-1 GS tabanlı cihazın iletkenlik değer sonuclarına göre elektrik alanın artmasıyla iletkenlik değerlerindeki artış Örnek-2 'ye göre daha az olduğu grafikten görülmektedir. Buna farklı

boyutlarda üretilen makro gözenekli yapıların neden olduğu düşünülmektedir. Şekil 3.e' de ise Örnek-1 ve Örnek-2' nin 5x103 Hz sabit frekansındaki iletkenliklerinin normalizasyonu verildi. Örnek-1'in gözenekleri daha büyük ve yüzey alanı aynı orantıda daha küçüktür. Elektrik alan etkisi, her iki örnekte de iletkenlikte artmaya neden olsa da, iletkenlik artış değeri; gözenekleri küçük ama yüzey alanı büyük olan Örnek-2' de daha fazladır. Yani Örnek-2'nin yüzey alanının büyük olması GS üzerinde daha sayıda bakteri fazla etkileşmesine neden olmuş, bu da iletkenlik değerlerinin daha fazla artmasını sağladı.



**Şekil 3.** (a) Örnek-1 ve (b) Örnek-2 GS tabanlı yapıların2x10<sup>7</sup> cfu*E.faecalis*konsantrasyonunda 0-5kV/cm ileri yönde uygulanan elektrik alan değerlerinde frekansa bağlı iletkenlik değişimi



d.







Şekil 3. (e) Örnek-1 ve Örnek-2 GS tabanlı yapıların 2x10<sup>7</sup> cfu*E.faecalis* konsantrasyonunda 0-5kV/cm ileri yönde uygulanan elektrik alan değerlerinde 5x10<sup>3</sup> Hz sabit frekansındaki normalizasyon grafiği

İletkenlik spektrumlarında gözlemlenen elektrik bağımlılığının alanı tersine cevrilebilirliğini kontrol etmek icin. avnı ölcümler Örnek-1 ve Örnek-2 GS tabanlı cihazları üzerinde ve ters taraflı elektrik alanı altındaki 2x107cfu Ε. faecalis bakteri konsantrasyonu icin de gerceklestirildi. Elektrik alanı tersine çevirebilmek için Şekil 1' de gösterilen üst plakaya pozitif voltaj uygulandı. Şekil 4.a ve 4.b' de verilen Örnek-1 ve Örnek-2 GS tabanlı cihazların ölcülen iletkenlik değerlerinin, uygulanan elektrik alanın artışıyla azalmakta olduğu gözlemlendi. Bu durum bize gözeneklerde birikmesinin, E.faecalis' in uygulanan elektrik alanının tersine göstermektedir. çevrilmesiyle azaldığını Bakterili sıvı içine GS yerleştirildiğinde bakterilerin bir kısmı doğal olarak yüzey ile bağ Sonra yüzeyden bakterileri kurar uzaklastırmak için o bağın kırılması gerekir. Ayrıca bakterinin kütlesi nedeni ile aşağıya doğru etkiyen yer çekimi kuvveti de vardır. Tüm bu etkilere rağmen ters yönde uygulanan elektrik alan yüzeyden bakteri uzaklaştırmayı başardı. Şekil 4.c ve 4.d' de sırasıyla Örnek-1 ve Örnek-2 GS tabanlı cihazların, ters yönde 0-5 uvgulanan kV/cm elektrik alan değerlerindeki iletkenlik değişimleri, 5x10<sup>3</sup> Hz sabit frekans değerinde incelendi. Grafiklerden, ters yönde uygulanan elektrik alanın artmasıyla

hem Örnek-1 hem de Örnek-2' deki iletkenlik değerindeki azalmalar net olarak görülmektedir. Bu sonuç bize bakterilerin bir kısmının ters elektrik alan etkisi ile GS yüzeyinden uzaklaştırabildiğini kanıtlar. Şekil 4.e' de ise Örnek-1 ve Örnek-2' nin 5x103 Hz sabit frekansındaki normalizasyon grafiği verilmektedir. Örnek-1' in gözenekleri daha büyük ve yüzey alanı aynı orantıda daha kücüktür. Dolavısı ile Örnek-1 GS vüzevi ile etkileşme içinde olan bakteri sayısı daha azdır. Diğer bir deyişle, Örnek-2 GS yüzeyinde etkileşmede daha çok bakteri var olduğu için ters elektrik alan etkisi ile yüzeyi terk eden bakteri sayısı da daha fazladır. Bu sebeple iletkenlik değeri daha hızlı azalır.





Şekil 4. (a) Örnek-1 ve (b) Örnek-2 GS tabanlı yapıların 2x10<sup>7</sup> cfu*E.faecalis*konsantrasyonunda 0-5kV/cm ters yönde uygulanan elektrik alan değerlerinde frekansa bağlı iletkenlik değişimi





c.

d.

Şekil 4. (c) Örnek-1 ve (d) Örnek-2 GS tabanlı yapıların 2x10<sup>7</sup> cfu*E. faecalis* konsantrasyonunda 0-5kV/cm ters yönde uygulanan elektrik alan değerlerinde 5x10<sup>3</sup> Hz sabit frekansı için iletkenlik değişimi



#### Şekil 4. (e) Örnek-1 ve Örnek-2 GS tabanlı yapıların 2x10<sup>7</sup> cfu*E.faecalis* konsantrasyonunda 0-5kV/cm ters yönde uygulanan elektrik alan değerlerinde 5x10<sup>3</sup> Hz sabit frekansındaki normalizasyon grafiği

Aynı deneyler altında, 0-5 kV/cm ileri ve ters yönde elektrik alanının uygulaması ile farklı makro boyutlara sahip GS tabanlı Örnek-1 ve Örnek-2 cihazlarındaki gözenekler üzerine birikmiş bakteri hücre sayısının frekansa bağlı değerleri kapasitans üzerindeki etkisi araştırıldı. Şekil 5.a ve 5.b' de sırasıyla farklı makro boyutlarda üretilen Örnek-1 ve Örnek-2' ye ait frekansa bağlı kapasitans grafikleri yarı logaritmik olarak verilmektedir. İleri yönde uygulanan 0-5 kV/cm elektrik alanının artmasıyla her iki örnek için de tüm frekans değerleri için kapasitans değerlerinde bir artış meydana geldiği görülmektedir. Kapasite, GS yüzeyindeki yük birikimi ile orantılıdır. Elektrik alan yardımı ile negatif yüklü bakterilerin GS yüzeyinde birikmeleri sonucu kapasitansta artış gözlenir. Şekil 5.c ve 5.d' de ise her iki örnek için de 5x10<sup>3</sup> Hz sabit frekans değerindeki kapasitans değerleri incelendi. Elektrik alan değeri arttıkça kapasitansta da artış devam eder. Şekil 5.e' de ise bu kapasitans değerlerinin artışları her iki örnek için de normalizasyonu karşılaştırıldı. Grafikten elde edilen sonuçlara göre, daha büyük gözenek boyutlarına sahip Örnek-1' in gözenek boyutlarının büyük olmasına bağlı yüzey alanının daha az oluşu nedeniyle bakteri hücresini kapasite etme değeri Örnek-2' ye göre daha azdır.











b.

Şekil 5. (a) Örnek-1 ve (b) Örnek-2 GS tabanlı yapıların 2x10<sup>7</sup> cfu *E.faecalis* konsantrasyonunda 0-5kV/cm ileri yönde uygulanan elektrik alan değerlerinde frekansa bağlı kapasitans değişimi



d.







Şekil 5. (e) Örnek-1 ve Örnek-2 GS tabanlı yapıların 2x10<sup>7</sup> cfu*E. faecalis* konsantrasyonunda 0-5kV/cm ileri yönde uygulanan elektrik alan değerlerinde 5x10<sup>3</sup> Hz sabit frekansındaki kapasitans normalizasyon grafiği

Ters yönde uygulanan 0-5 kV/cm elektrik alan değerlerinin frekansa bağlı kapasitans değisimleri Sekil 6.a ve 6.b' de yarı logaritmik olarak verildi. Farklı gözenek boyutlarına sahip Örnek-1 ve Örnek-2 GS tabanlı yapıların E. faecalis bakteri konsantrasyonu icerisindeki kapasitans değerlerinin, artan elektrik alan değeri ile birlikte bir azalış gösterdiği belirlendi. Önceki deneylerle uyumlu biçimde, bakterili sıvı içine GS yerleştirildiğinde bakterilerin bir kısmı doğal olarak yüzey ile bağ kurar. Sonra yüzeyden bakterileri uzaklaştırmak için o bağın kırılması gerekir. Ayrıca bakterinin kütlesi nedeni ile aşağıya doğru etkiyen yer çekimi kuvveti de vardır. Yine de ters yönde uygulanan elektrik alan yüzeyden bakteri uzaklaştırmayı başardı. Ancak ters yönde uygulanan elektrik alanın kapasitans değerlerindeki değişimi, ileri yöndekine göre oldukça küçük olduğu görüldü. Şekil 6.c ve 6.d' de ise her iki örnek için de 5x103 Hz sabit frekans değerindeki zamana bağlı kapasitans değerleri incelendi. Grafikten elde edilen sonuçlara göre, ters yönde uygulanan elektrik alanının artmasıyla her iki örnekte de kapasitans değerlerinde azalma gözlemlendi. Bu sonuç da bize bakterilerin bir kısmının ters elektrik alan etkisi ile GS yüzeyinden uzaklaştırabildiğini kanıtlar. Şekil 6.e' de ise Örnek-1 ve Örnek-2' nin 5x103 Hz sabit frekansındaki kapasitans değerlerinin verilmektedir. normalizasyonu Örnek-1'in gözenekleri daha büyük ve yüzey alanı aynı orantıda daha küçüktür. Dolayısı ile Örnek-1 GS yüzeyi ile etkileşme içinde olan bakteri sayısı daha azdır. Bu azlık empedans değerindeki değişim azlık oranını açıklar. Yani Örnek-2 GS yüzeyinde etkileşmede daha çok bakteri var olduğu için ters elektrik alan etkisi ile yüzeyi terk eden bakteri savısı da daha fazladır. Bu sebeple kapasitans değeri azalma hızı daha fazladır.



a.





Şekil 6. (a) Örnek-1 ve (b) Örnek-2 GS tabanlı yapıların 2x10<sup>7</sup> cfu *E.faecalis* konsantrasyonunda 0-5kV/cm ters yönde





uygulanan elektrik alan değerlerinde frekansa



c.



Şekil 6. (c) Örnek-1 ve (d) Örnek-2 GS tabanlı yapıların 2x107 cfu *E.faecalis* konsantrasyonunda 0-5kV/cm ters yönde uygulanan elektrik alan değerlerinde 5x10<sup>3</sup> Hz sabit frekansı için kapasitans değişimi





**Şekil 6.** (e) Örnek-1 ve Örnek-2 GS tabanlı yapıların 2x10<sup>7</sup> cfu *E. faecalis*konsantrasyonunda 0-5kV/cm ters yönde uygulanan elektrik alan değerlerinde 5x10<sup>3</sup> Hz sabit frekansındaki kapasitans normalizasyon grafiği

## 4. Tartışma ve Sonuç

Bakterilerin elektriksel yük taşıyor olmaları, elektrik alan yardımı ile hareketlerinin kontrol edilebileceği fikrini doğurdu. Elektrik alan ile kontrol edilecek olan bu hareket kabiliyetini, bakteri-sensör yüzey etkileşiminin arttırılmasında kullanmak istedik. Bu amaçla, farklı makro gözenek boyutlarında GS tabanlı iki farklı sensör platformu üretilerek, bu platformlarda elektrik alan vardımı ile bakteri hücresi biriktirildi. Farklı anodizasyon koşulları altında hazırlanan bu iki platform için ileri ve ters yönde elektrik alan uygulanması ile sabit bakteri hücre konsantrasvonundaki sıvıda iletkenlik-frekans ve kapasitans-frekans spektrumları etkisi kaydedildi. üzerine Sonuçlara göre, sabit bakteri konsantrasyonlu incelenen Örnek-1 sıvıda ve Örnek-2 cihazlarının her ikisi içinde iletkenlik ve kapasitans değerlerinin, ileri yönde elektrik alanının arttırılmasıyla arttığı gösterildi. Öte yandan, ters elektrik alanının cihazın iletkenlik ve kapasitansında azalmaya neden olduğu görüldü. Farklı makro boyutlarında üretilen bu iki cihaz karşılaştırıldığında ise; Örnek-2 GS tabanlı (gözenekleri daha küçük ve yüzey alanı daha büyük) sensör platformunun, iletkenlik ve kapasitans değerlerinin, elektrik alanın

artmasıyla daha çok artış gösterdiği tespit edildi. 1-5  $\mu$ m gözenek boyutlarına sahip bu cihazın yüzey alanının daha büyük olması nedeniyle elektriksel iletkenliğinin daha iyi ve daha çok bakteri ile etkileşimde olduğu sonucuna varıldı.

#### Teşekkür

Bu çalışma Yıldız Teknik Üniversitesi Araştırma Fonu tarafından desteklenmiştir (Proje no. 2015-01-01-KAP03). Yazarlar ayrıca, *E. faecalis* bakteri hücrelerini temin ettikleri için Prof. Dr. F. Köksal Çakırlar' a (İstanbul Üniversitesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Mikrobiyoloji Laboratuvarı) teşekkür eder. Ayrıca yazarlar cihaz kullanımı için Yıldız Teknik Üniversitesi Prof.Dr.Ahmet Altındal'a teşekkür eder.

### Kaynakça

- [1] A. Jane, R. Dronov, A. Hodges, and N. H. Voelcker, "Porous silicon biosensors on the advance," *Trends in Biotechnology*. 2009, doi: 10.1016/j.tibtech.2008.12.004.
- [2] R. L. Smith and S. D. Collins, "Porous silicon formation mechanisms," J. Appl. Phys., 1992, doi: 10.1063/1.350839.
- [3] A. Julbe and J. D. F. Ramsay, "Chapter 4 Methods for the characterisation of porous structure in membrane materials," *Membr. Sci. Technol.*, 1996, doi: 10.1016/S0927-5193(96)80007-6.
- [4] K. Kobayashi, F. A. Harraz, S. Izuo, T. Sakka, and Y. H. Ogata, "Macropore growth in a prepatterned p-type silicon wafer," *Phys. Status Solidi Appl. Mater. Sci.*, 2007, doi: 10.1002/pssa.200674325.
- [5] A. Uhlir, "Electrolytic Shaping of Germanium and Silicon," *Bell Syst. Tech. J.*, 1956, doi: 10.1002/j.1538-7305.1956.tb02385.x.
- [6] P. M. Z. Hasan, V. K. Sajith, M. Shahnawaze Ansari, J. Iqbal, and A. Alshahrie, "Influence of HF concentration and current density on characteristic morphological features of mesoporous silicon," *Microporous Mesoporous Mater.*, 2017, doi: 10.1016/j.micromeso.2017.04.059.
- [7] I. Rea *et al.*, "Fabrication and characterization of a porous silicon based microarray for label-free optical monitoring of biomolecular interactions," *J. Appl. Phys.*, 2010, doi: 10.1063/1.3273410.
- [8] T. J. Barnes, K. L. Jarvis, and C. A. Prestidge, "Recent advances in porous silicon technology for drug delivery," *Therapeutic Delivery*. 2013, doi: 10.4155/tde.13.52.
- [9] B. Gupta, Y. Zhu, B. Guan, P. J. Reece, and J. J. Gooding, "Functionalised porous silicon as a biosensor: Emphasis on monitoring cells in vivo and in vitro," *Analyst.* 2013, doi: 10.1039/c3an00081h.
- [10] R. J. Martin-Palma, "Biomedical applications of nanostructured porous silicon: a review," J. Nanophotonics, 2010, doi: 10.1117/1.3496303.
- [11]S. M. Yoo and S. Y. Lee, "Optical Biosensors for the

Detection of Pathogenic Microorganisms," *Trends in Biotechnology*. 2016, doi: 10.1016/j.tibtech.2015.09.012.

- [12] H. Bai, N. Cochet, A. Pauss, and E. Lamy, "Bacteria cell properties and grain size impact on bacteria transport and deposition in porous media," *Colloids Surfaces B Biointerfaces*, 2016, doi: 10.1016/j.colsurfb.2015.12.016.
- [13]S. B. T. De-Leon, R. Oren, M. E. Spira, N. Korbakov, S. Yitzchaik, and A. Sa'ar, "Porous silicon substrates for neurons culturing and bio-photonic sensing," in *Physica Status Solidi (A) Applications and Materials Science*, 2005, doi: 10.1002/pssa.200461136.
- [14] E. Punzón-Quijorna et al., "Nanostructured porous silicon micropatterns as a tool for substrateconditioned cell research," *Nanoscale Res. Lett.*, 2012, doi: 10.1186/1556-276X-7-396.
- [15] A. T. Poortinga, R. Bos, and H. J. Busscher, "Lack of effect of an externally applied electric field on bacterial adhesion to glass," *Colloids Surfaces B Biointerfaces*, 2001, doi: 10.1016/S0927-7765(00)00184-3.
- [16] N. Massad-Ivanir et al., "Porous Silicon-Based Biosensors: Towards Real-Time Optical Detection of Target Bacteria in the Food Industry," Sci. Rep., 2016, doi: 10.1038/srep38099.
- [17] N. Pal, S. Sharma, and S. Gupta, "Sensitive and rapid detection of pathogenic bacteria in small volumes using impedance spectroscopy technique," *Biosens. Bioelectron.*, 2016, doi: 10.1016/j.bios.2015.09.037.
- [18] A. Bogomolova *et al.*, "Challenges of electrochemical impedance spectroscopy in protein biosensing," *Anal. Chem.*, 2009, doi: 10.1021/ac9002358.
- [19] H. J. Schütt and E. Gerdes, "Space-charge relaxation in ionicly conducting oxide glasses. I. Model and frequency response," J. Non. Cryst. Solids, 1992, doi: 10.1016/S0022-3093(05)80377-1.
- [20] R. D. Das, C. RoyChaudhuri, S. Maji, S. Das, and H. Saha, "Macroporous silicon based simple and efficient trapping platform for electrical detection of Salmonella typhimurium pathogens," *Biosens. Bioelectron.*, 2009, doi: 10.1016/j.bios.2009.04.014.
- [21] R. D. Das, A. Dey, S. Das, and C. Roychaudhuri, "Interdigitated electrode-less high-performance macroporous silicon structure as impedance biosensor for bacteria detection," *IEEE Sens. J.*, 2011, doi: 10.1109/JSEN.2010.2087746.
- [22] R. D. Das, N. Mondal, S. Das, and C. Roychaudhuri, "Optimized electrode geometry for an improved impedance based macroporous silicon bacteria detector," *IEEE Sens. J.*, 2012, doi: 10.1109/JSEN.2011.2175724.
- [23] P. B. Lillehoj, C. W. Kaplan, J. He, W. Shi, and C. M. Ho, "Rapid, Electrical Impedance Detection of Bacterial Pathogens Using Immobilized Antimicrobial Peptides," J. Lab. Autom., 2014, doi: 10.1177/2211068213495207.
- [24] K. Samantaray, S. R. Mishra, G. Purohit, and P. S.

Mohanty, "AC Electric Field Mediated Assembly of Bacterial Tetrads," *ACS Omega*, 2020, doi: 10.1021/acsomega.9b04124.

- [25] S. Pudasaini, A. T. K. Perera, S. S. U. Ahmed, Y. B. Chong, S. H. Ng, and C. Yang, "An electroporation device with microbead-enhanced electric field for bacterial inactivation," *Inventions*, 2020, doi: 10.3390/inventions5010002.
- [26]B. Jiang *et al.*, "Impacts of long-term electric field applied on the membrane fouling mitigation and shifts of microbial communities in EMBR for treating phenol wastewater," *Sci. Total Environ.*, 2020, doi: 10.1016/j.scitotenv.2020.137139.
- [27] T. F. Kong, P. Y. Tan, B. Z. Tay, X. Shen, and Marcos, "Bacteria and cancer cell pearl chain under dielectrophoresis," *Electrophoresis*, 2021, doi: 10.1002/elps.202000277.
- [28] S. Güler, Ç. Oruç, and A. Altındal, "Electric field assisted deposition of E. coli bacteria into the pores of porous silicon," *J. Microbiol. Methods*, 2019, doi: 10.1016/j.mimet.2019.04.018.
- [29]C. Oruc and S. Guler, "Effect of Au, Ag and Cu thin films' thickness on the electrical parameters of metalporous silicon direct hydrogen fuel cell," Int. J. Hydrogen Energy, 2014, doi:

10.1016/j.ijhydene.2014.10.017.

- [30] Ç. ORUÇ, S. GÜLER, and H. M. LUŞ, "Metal-Gözenekli Silisyum Direk Hidrojen Pili Üretim Parametrelerinin Geliştirilmesi," *Gazi Üniversitesi Fen Bilim. Derg. Part C Tasarım ve Teknol.*, 2018, doi: 10.29109/gujsc.383081.
- [31] M. Merve Yüzüak, S. Altun, A. Altindal, and Z. Odabaş, "Dielectric properties and electronic absorption: A comparison of novel azo- and oxo-bridged phthalocyanines," *Dalt. Trans.*, 2014, doi: 10.1039/c4dt02998d.
- [32] F. A. Harraz, "Porous silicon chemical sensors and biosensors: A review," Sensors Actuators, B Chem., 2014, doi: 10.1016/j.snb.2014.06.048.
- [33] H. Anany, W. Chen, R. Pelton, and M. W. Griffiths, "Biocontrol of Listeria monocytogenes and Escherichia coli 0157:H7 in meat by using phages immobilized on modified cellulose membranes," *Appl. Environ. Microbiol.*, 2011, doi: 10.1128/AEM.05493-11.
- [34] J. H. Han *et al.*, "Capture and detection of T7 bacteriophages on a nanostructured interface," ACS Appl. Mater. Interfaces, 2014, doi: 10.1021/am500655r.